This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号 特別2001-110321

(P2001 - 110321A)

(43)公開日 平成13年4月20日(2001.4.20)

FI 5-73-17(參考) (51) Int.Cl.³ 越別高!针 11/02 4 D 0 7 5 H 0 1 J 11/02 HOLJ 1/40 B 0 5 D 1/404 J 0 3 8 B 0 5 D 9/02 5 C O 2 7 9/02 110 1 J HOIJ 11/00 5 C 0 4 0 11/00 C 0 9 D 185/00 # C O 9 D 185/00 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 日) 特願平11-284212 (71) 出版人 000005223 (21)出職從号 實上通株式会社。 神泰用県川崎市中原区上小田中4丁目1番 (22) /旧輪日 平成11年10月 5 日(1999, 10.5) (72) 発明者 日高 鶴一郎 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1 科 省上通珠式会社内 (72)発明者 中澤 明 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁月1番 1号 富士通珠式会社内

最終真に続く

(54) 【発明の名称】 ブラズマディスプレイパネル (57) 【要約】

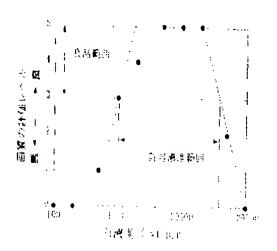
【課題】 本発明は、脂肪酸塩の熱分解により形成した Mgの限を保護限として採用したプラズマディスプレイ パネルに関し、点灯すべきセルが点灯しない"黒ノイ ズ"の発生率を低減し、パネルの表示品質を高めること を目的とする。

【解決手段】 -対の基板の少なくとも一方の基板上に配設された電極が、誘電体層で被覆され、前記一対の基板内に充填される放電ガスから絶縁されてなる構成のブラズマディスプレイパネルにおいて、前記誘電体層上に少なくとも放電ガスと接する保護限として、脂肪酸場の熱分解により形成された酸化マグネシウム、関が設けられ、該酸化マグネシウム、関は原子価が3以上の元素、例えば理素を1000~4000重重ppmの割合で含んでなる構成とする。

· 划在自体自己。在充在度是基在《小划图》方法图

弁理士 岩田 改

(74)代理人 100109852



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一対の基板の少なくとも一方の基板上に配設された電極が、誘電体層で被覆され、該一対の基板内に充填される放電がスから絶縁されてなる構成のブラスマディスプレイパネルであって、

前記録を休屋上に形成される保護限として、脳助酸塩の 熱分解により形成された酸化マグネシウム 既が設けられ ていることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。 【請求項 2】 前記酸化マグネシウム 限は、酸化マグネ シウム の一部のマグネシウム を原子価が3価以上の元素

【請求項 2】 前記酸化マグネシウム 膜は、酸化マグネシウム の一部のマグネシウム を原子価が3価以上の元素 で置換した構成からなることを持数とする請求項 1 に記 載のプラスマディスプレイパネル。

(請求項 3) 前記原子価が3以上の元素は、珪素およびアルミニウム のうちの少なくとも一つであ ることを特徴とする請求項 2に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項 4】 前記原子価が3以上の元素として、建素を1000~4000重度 ppmの割合で含むことを特徴とする請求項 2に記載のプラスマディスプレイパネル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マトリクス表示方式のAC型プラズマディスプレイパネル(PlasmaDispla y Pane I: PDP) IC関し、特に画面に沿った放電を生じさせる面放電形式のPDPに好通なパネル構成に関するものである。

【0002】近年、PDPは、カラー画面の実用化を機にテレビジョン映像やコンピュータのモニターなどの用途で広く用いられるようになり、ハイビジョン用の大画面フラット型デバイスとしても注目されている。

【0003】マトリクス表示方式のPDPにおいて、表示素子であるセルの点灯状態の維持(サステイン)にメモリ効果が利用されている。AC型PDPは、電極を誘電体で被覆することにより構造的にメモリ機能を有するように構成されている。すなわち、AC型PDPによるように際しては、点灯(発光)すべきセルのみに重電荷を審核させるライン順次のアドレッシングを行い、その後に全てのセルに対して一斉に放電開始電圧より低い交番極性の電圧(サステイン電圧)を印加する。

[0004]

【従来の技術】商品化されている面放電形式のPDPでは、マトリクス表示のライン毎に画面の全長にわたって延びる一対のサステイン電極(第1及び第2の電極)が平行に配置され、列毎にアドレス電極(第3の電極)が配置されている。各ラインにおけるサステイン電極間隠は"放電スリット"と呼称されており、その幅は20~~250ボルト程度の実効電圧の印加で面放電が生じる値(例えば50~100μm)に選定されている。【0005】一方、隣接するライン同士の間におけるサ

ステイン電極間隙は"送スリット"と呼称されている。 該送スリットの幅は放電スリットよりも十分に大きい値 に選定されている。すなわち、送スリットを隔てて並ぶ サステイン電極同士の間での面放電が防止されている。 このように、放電スリット及び送スリットを設けてサス テイン電極を配列することにより、各ラインを選択的に 発光させることができる。

【0006】サステイン電極を被覆する誘電体層(例えば低融点ガラス層)の表面には、放電時のイオン衝撃の影響を軽減する耐スパッタ性の保護限が設けられている。該保護限は放電ガスと直接的に接ずることから、その材質及び限質が放電特性に大きな影響を与えることになり、一般に、保護限材料として酸化マグネシウム(Mgの:マグネシア)が用いられている。該Mgのは耐スパッタ性に優れ、且つ二次電子放出係数の大きい絶縁物である。つまり、Mgのを保護限に用いることによって放電開始電圧が下がって駆動が容易になる。このMgの限からなる保護限は、Mgの結晶の粒の群を蒸着源とした電子ビーム 素書法等により形成されていた。【0007】

【発明が解決しようとする課題】 一方、電子ピーム 燕着 法等よりも簡易にMeの膜を形成するために、発明者ら は新たに、例えばエナント酸マグネシウム 〔(C6 H13 COO) 2 Mg) と、エタノール (C2 H5 OH) と、 PGMEA (プロピレングリコールモノメチルエーテル アセテート)とを重量比で 1: 1. 5:1の割合で混合 して調製した途布溶液を、前記サステイン電極を被覆し た誘電体層の表面にスピナー等によって塗布し、乾燥し た塗布膜を前記サステイン電極を被覆した誘電体層が設 けられた基板と共に、大気中500℃で2時間ほど焼成 することにより前記談電体層の表面に 1 μ m程度の厚さ のMeO膜からなる保護膜を形成することを検討した。 【0008】しかし、そのようなMeの膜を保護膜として用いた場合には、"黒ノイズ"と呼称される表示の乱 れが多発するという問題があった。"黒ノイズ"とは、 点灯すべきセル(選択セル)が点灯しない現象であり、 画面のうちの点灯領域と非点灯領域との境界で生じ鳥 い。1つのライン又は1つの列における複数の選択セル の全てが点灯しないというものではなく、発生部位が点 在することから、黒ノイズの原因はアドレス放電が生じ ないか又は生じても強度が足りないアドレスミスであ る と言える。

【0009】アドレスミスの原因としては、逆スリットにおける壁電荷の残智が考えられ、リセットバルスによる面放電が週割に拡がって逆スリットにも壁電荷が帯電した場合、その後に自己消去放電が生じても放電スリットから遠い逆スリットに在る壁電荷は残留する。この残留電荷によってアドレッシングの実効電圧が下がり、アドレスミスが起こるものと考えられる。

【0010】近傍のセルが選択セルであ れば、その近傍

のセルでのアドレス放電による空間電荷がプライミング 効果に寄与するので、アドリスミスは起こりにくい。これに対して、上述の境界のように近傍のセル(特にスキャンニングの前方側)が非選択セルである場合では、プライミング効果が生じないので、アドレスミスが起こり 見い。

【0011】本発明は上記した従来の問題点に鑑み、脂肪酸塩の熱分解により形成したMを O 限を保護限として採用したプラズマディスプレイパネルにおいて、点灯すべきセルが点灯しない"黒ノイズ"の発生率を低減し、表示品質を高めることを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】脂肪酸塩を熱分解したM c O 映を保護映として用いた場合、黒ノイズの発生の度合いは、その映内に含有される不純物材料およびその含有重並びにその形成条件等に依存することが判明した。

[0012]

【0013】前記酸化マグネシウム 膜の特定の膜質と黒ノイズの発生との関係を調べると、該酸化マグネシウム (MgO) に対する理素(Si) の含有量が一定範囲内の値である場合には黒ノイズの発生の度合いが小さいら結果を得た。またホウ素(B)、炭素(C)、カルシウム(Ca) については、黒ノイズの発生率の大きい試料と小さい試料との間で顕著な差異が無かった。理素と同じくマグネシウム より原子価の大きい(3以上)の元素、特にイオン半径がマグネシウム に近い3 a 族又は4 a 族の元素の中に、理素と同様の作用を呈するものがあると推定できる。

【0014】黒ノイズの原因であるアドレスミスが抑制される理由としては、前記酸化マグネシウム 映は、酸化マグネシウム の一部のマグネシウム を原子価が3以上の元素、例えば建素で置換される構成となることからその電気的特性が改善され、二次電子の放出動が増大して残留電荷による実効電圧の低下が通われること、電荷の残留自体が超過されること、残留電荷が速やかに消失することなどが考えられる。

【0015】即ち、請求項 1の発明は、一対の基板の少なくとも一方の基板上に配設された電極が、誘電体層で被覆され、該一対の基板内に充填される放電ガスから絶縁されてなる構成のPDPであって、前記誘電体層上に形成される保護膜として、脂肪酸塩の熱分解により形成された酸化マグネシウム 関が設けられている構成とする

【0016】請求項 2の発明は、前記酸化マグネシウム 関は、酸化マグネシウム の一部のマグネシウム を原子価 が3価以上の元素で置換した構成からなる。請求項 3の 発明は、前記原子価が3以上の元素は、珪素およびアル ミニウム のうちの少なくとも一つであ る。

【0017】請求項 4の発明は、前記原子価が3以上の元素として、珪素を1000~4000重量ppmの割合で含む構成とする。

[0018]

【発明の実施の形態】以下図面を用いて本発明の実施例 について詳細に説明する。図1は本発明に係るプラズマ 表示装置100のプロック図である。

【0019】該プラズマ表示装置100は、マトリクス 形式のカラー表示デバイスであるAC型のPDP1と、 画面(スクリーン)を構成する多数のセルを選択的に点 灯させるための駆動ユニット80とからなり、単掛け式 テレビジョン受像機、コンピュータシステムのモニター などとして利用される。

【0020】PDP1は、一対のサステイン電極×、Yが平行配置された面放電形式のPDPであり、各セルにサステイン電極×、Yとアドレス電極×とが対応する3電極構造の電極マトリクスを有している。

【〇〇21】 サステイン電極×、 Y は画面のライン方向 (水平方向) に延び、一方のサステイン電極 Y はアドレッシングに際してライン単位にセルを選択するためのスキャン電極として用いられる。アドレス電極 A は列単位にセルを選択するためのデータ電極であり、列方向(重直方向)に延びている。

【0022】駆動ユニット80は、コントローラ81、フレーム メモリ82、メドライバ回路86、Yドライバ回路88、アドレスドライバ回路88、及び図示しない電源回路を有している。また前記駆動カニニット80には水部装置から各ピクセルのRGBの輝度レベル(階調レベル)を示す多値の映像データDR、DG、DBは、フレーム メモリ82に一旦格納された 後、コントローラ81によって各色毎にサブフレーム データDs 1に変換され、再びフレーム メモリ82に一般される。該サブフレーム データDs 1に変換され、再びフレーム 、番調表のために1フレーム を分割した各サブフレーム におけるセルの点灯の要否を示す2値データの集合である。

【0023】×ドライバ回路86は、サステイン電極×に対する電圧的加を担い、Yドライバ回路87はサステイン電極Yに対する電圧印加を担う。アドレスドライバ回路88は、フレーム メモリ82から転送されたサブフレーム データロッチに応じて、アドレス電極Aに選択的にアドレス電圧を印加する。

【0024】次に、PDP1に適用する駆動方法を説明する。図2はフレーム 分割の模式図であ り、図3は駆動シーケンスを示す電圧波形図であ る。

【0025】図2のように、セルの発光の2値制御によって暗調再現を行うためには、外部からの入力画像である時系列の各フレーム Fを、例えば6個のサブフレーム s f 1, s f 2, s f 3, s f 4, s f 5, s f 6 に分割する。各サブフレーム s f 1 \sim s f 6 における輝度の 相対比率が 1:2:4:8:16:32となるように重 か付けをして、各サブフレーム s f 1 \sim s f 6のサステインの発光回数を設定する。サブフレーム 単位の発光の

有無の組合せでRGBの各色毎にレベル「ロ」~「63」の64段階の輝度設定を行うことができるので、表示可能な色の数は643となる。なお、サブフレーム s 11~s 16を輝度の重みの頂に表示する必要はない。例えば重みの大きいサブフレーム s 16を表示期間の中間に配置するといった最適化を行うことができる。

【0026】次に図3のように、各サプフレーム sf1 ~sf6に対して、リセット期間エR、アドレス期間エA、及びサステイン期間エSを割り当てる。リセット期間エR及びアドレス期間エAの長さは輝度の重みに係わらず一定であるが、サステイン期間エSの長さは輝度の重みが大きいほど長い。つまり、各サプフレーム sf1 ~sf6の表示期間の長さは互いに異なる。

【0027】該リセット期間TRは、それ以前の点灯状態の影響を防ぐため、画面全体の壁電荷の消去(初期化)を行う期間である。全てのライン(ライン数はn)のサステイン電極×に波高値が面放電開始電圧を越えののサステイン電極×に波高値が面放電開始電圧を越える帯電とイオン衝撃を防ぐために全てのアドレス電極とのボルスを印加する。リセットバルスPwの立と、地域に呼応して全てのラインで強い面放電が生じ、相談のよって実動性がある。リセットバルスPwが立めによって実動性ががあ。リセットバルスPwが立たしまって実動性がある。リセットバルスPwが立たしたると、全電圧がそのまま実効地圧がなりませい。全でのセルにおいてほとんどの整電荷が消失し、全てのセルにおいてほとんどの整電荷が消失し、

【〇〇28】前記アドレス期間下Aは、アドレッシング (点灯/非点灯の設定)を行う期間である。サステイン 電極×を接地電位に対して正電位にバイアスし、全ての サステイン電極Yを負電位にバイアスする。この状態 で、先頭のラインから1ラインすつ順に各ラインを選択 し、該当するサステイン電極Yに負極性のスキャンパル スPyを印加する。ラインの選択と同時に、サブフレームデータDs f が示す点灯すべきセルに対応したアドレス電極Aに対して正極性のアドレスパルスPsを印加する。

【0029】選択されたラインにおいて、アドレスバルスP®の印加されたセルでは、サステイン電極Yとアドレス電極Aとの間で対向放電が起こり、それが面放電に移行する。これら一連の放電がアドレス放電である。サステイン電極XがアドレスパルスP®を目極性の電位にパイアスされているので、そのパイアスでアドレスパルスP®が打ち消され、サステイン電極Xとアドレス電極Aとの間では放電は起きない。

【0030】前記サステイン期間下らは、階調レベルに応じた健康を確保するために、設定された点灯状態を維持する期間である。不要の放電を防止するため、全てのアドレス電優へを正極性の電位にパイアスし、最初に全てのサステイン電優とに正極性のサステインパルスPsを印加する。その後、サステイン電優×とサステイン電

極Yとに対して交互にサステインパルスPsを印加する。サステインドルスPsの印加毎に、アドレス期間TAにおいて望竜筒の番様したセルで面放電が生じる。サステインパルスPsの印加周期は一定であり、輝度の重みに応じて設定された個数のサスティンパルスPsが印加される。

【〇〇31】図4は本発明のPOP1の内部構造を示す斜視図である。PDP1では、放電空間30を挟む基板対のうちの前面側のガラス基板11の内面に、画面の水平方向のセル列であるラインに毎に一対ずつサステイン電極メ、Yが配列されている。サスティン電極メ、Yの配列されている。技術がは過ぎる機関するとからなり、AC駆動のための誘電体層17のは関されている。誘電率は約10)である。誘電体層17のは関されている。誘電体層17のは関のMEOは、高を関するとは、その関係は対するのとでいる。誘電体層17のよっなは、プラスでは、誘電体層170日のよっている。影電体層17万とでは、大きを関係を関係である。大きを関係を関係に、対して、大きを関係を関係に対して、大きを関係を関係を関係を表している。

【0032】また骨面側のガラス基板21の内面には、下地層22、アドレス電極A、絶縁層24、隔壁29、及びカラー表示のための3色(R, G, B) の蛍光層28R, 28Bが設けられている。各隔壁29は平面視において直線状である。これら隔壁29によいで放電空間30がライン方向にサブピクセル(単位変光質域)毎に区画され、且つ放電空間30の間隙寸送光度値(150μm程度)に規定されている。放電空間30には、ネオンに微量のキセノンを退合した放電ガスが充填されている。前記蛍光体層28R, 28G, 28Bは、放電で生じた紫外線で局部的に励起されて所定色の可視光を放つ。

【0033】表示の1ピクセルはライン方向に並ぶ3つのサブピクセルで構成される。各サブピクセルの範囲内の構造体がセルである。瞬壁29の配置バターンがストライブバターンであることから、放電空間30のうちの各列に対応した部分は、全てのラインに跨がって列方向に連続しており、各列内のサブピクセルの発光色は同一である。

【0034】以上の構造のPDP1は、各ガラス基板11,21について別個に所定の構成要素を設けて前面及び背面用の基板構体を重ね合わせて対向間隙の周縁を封止し、内部の排気及び放電ガスの充填を行う一速の工程によって製造される。なお、その前面用の基板構体の作製において、Me○映18は、黒ノイズの低退に有効な映質が得られるように選定された条件で成映される。

【0035】以下、本発明の特徴とするMe O限 18の 関質とPDPに適用した場合の画質について説明する。 先ず、PDP1を構成する、例えばガラス基板11,2 1に対して別個に所定の構成要素を設けて作成した損数 の前面及び骨面用の基板構体(以下、前面用電極基板及 び骨面用電極基板と称する)を用意し、少なくとも前面 用電極基板のそれぞれの表面に以下の互いに異なる条件 でMe O膜を設ける。

【0036】例えば、試料1として、マグネシウムの脂肪酸塩であるエナント酸マグネシウム((C6 H13C0 O)2 Me)と、エタノール(C2 H5 OH)と、PG MEA(プロピレングリコールモノメチルエーテルトナー・シンを重量比で1:1、5:1の割合で混らして調製した塗布溶液(以下、標準溶液とも称する)を、用意した前面用電極基板の誘電体層の表面にスピナー等により塗布し、乾燥する。その塗布膜を前記基板と共に、大気中500で2時間ほど焼成して前記誘電体層の表面に対り000点の厚さのMe O膜からなる保護膜を形成して試料1を得た。

【0037】次に試料2として、前記標準 溶液に、該標準 溶液中のエナント酸マグネシウム に対して珪素の脂肪酸場であ るエナント酸シリコン ((C6 H13COO) 4 Siを重量比で1:0.000275の割合で添加し混合して調製した途布溶液を、用意した前面用電極基板の誘・体層の表面に基板と共に、大気中500℃を時間とした途布限を前記基板と共に、大気中500℃を時間とした途流して前記誘・電体層の表面に約70004の厚さのMeの映(前含有温度が 100重量 ppm)からなる保護膜を形成して試料2を得た。

【0038】次に試料3として、前記標準 溶液に、該標準 溶液中のエナント酸マグネシウム に対してエナント酸マグネシウム に対してエナント酸 シリコンを重量比で1:0.000550の割合で添加し混合して調製した途布溶液を、用意した前面用電極基板の誘電体層の表面にスピナー等により一様に途布し、乾燥した途布限を前記基板と共に、大気中500で2時間ほど焼成して前記記録電体層の表面に約7000点の厚きのMをの映(Si含有温度が200重量PPM)からなる保護膜を形成して試料3を得た。

【0039】次に試料4をして、前記標準 溶液に、診標準 溶液中のエナント酸マグネシウム に対してエナント酸シリコンを重量比で1:0.001375の割合で添加し場合して調製した途布溶液を、用意した前面用電極基板の誘電体層の表面にスピナー等により一様に途布し、依線した途布限を前記基板と共に、大気中500で2時間ほど焼成して前記誘電体層の表面に約7000点の厚さのMzO膜(Si含有温度が500重量ppm)からなる保護膜を形成して試料4を得た。

【0040】次に試料5として、前記標準 溶液に、診標準 溶液中のエナント酸マグネシウム に対してエナント酸シリコンを重量比で1:0.00275の割合で添加し退合して調製した塗布溶液を、用意した前面用電極基板の誘電体層の表面にスピナー等により一様に塗布し、乾

燥した塗布膜を前記基版と共に、大気中500℃で2時間ほど焼成して前記談電体層の表面に約7000人の厚さのMeO膜(Si含有濃度が1000重型ppm)からなる保護膜を形成して試料5を得た。

【0041】次に試料6として、前記標準 溶液に、該標準 溶液中のエナント酸マグネシウム に対してエナント酸 シリコンを重重比で1:0.0055の割合で添加し退合して調製した途布溶液を、用意した前面用電極基板の誘電体層の表面にスピナー等により一様に途布し、乾燥した途布限を前記基板と共に、大気中500℃で2時間はど焼成して前記誘電体層の乗面に約7000点の保護限のMeの限(536名有濃度が2000重量ppm)からなる保護限を形成して試料5を得た。

【0042】次に試料7として、前記標準 溶液に、該標準 溶液中のエナント酸マグネシウム に対してエナント酸シリコンを重量比で1:0.01375の割合で添加し退合して調製した途布溶液を、用意した前面用電極基板の誘電体層の表面にスピナー等により一様に途布し、乾燥した途布限を前記誘電体層の表面に約7000本の厚質のMeO膜(Si含有濃度が5000重型ppm)からなる保護膜を形成して試料7を得る。

【0043】次に試料8として、前記標準 溶液に、該標準 溶液中のエナント酸マグネシウム に対してエナント酸シリコンを重重比で1:0.0275の割合で添加し退合して調製した途布溶液を、用煮した前面用電極基板の誘電体層の表面にスピナー等により一様に途布し、乾燥した途布限を前記基礎と共に、大気中500℃で2時度と低減して前記誘電体層の表面に約7000ムの厚さのMeの膜(3)含有濃度が 10000重型ppm)からなる保護限を形成して試料8を得た。

【〇〇44】次に試料9として、前記標準溶液に、該標準溶液中のエナント酸マグネシウム に対してエナント酸シリコンを重重比で1:0.0550の割合で添加し退合して調製した塗布溶液を、用意した前面用電極基板の誘電体層の表面にスピナー等により一様に塗布し、乾燥した塗布限を前記基板と共に、大気中500℃で2時間はど焼成して前記誘電体層の表面に約7000人の厚さのMgの限(Si含有濃度が20000重量ppm)からなる保護膜を形成して試料9を得た。

【0045】次に試料10として、前記標準 溶液に、該標準 溶液中のエナント酸マグネシウム に対してエナント酸シリコンを重量比で1:0、1375の割合で添加し退合して調製した途布溶液を、用意した前面用電極基板の誘電体層の表面にスピナー等により一体に途布し、乾燥した途布膜を前記基板と共に、大気中500で2時間ほど焼成して前記誘電体層の表面にわ7000のの厚さのMeO膜(Si含有濃度が50000重量ppm)からなる保護膜を形成して試料10を得た。

【0046】次に試料11として、前記標準 溶液に、該

標準 溶液中のエナント酸マグネシウム に対してエナント酸シリコンを重量比で1:0.275の割合で添加し退合して調製した途布溶液を、用煮した前面所電極基板の誘電体層の表面にスピナー等により一様に途布し、乾燥した途布限を前記基板と共に、大気中500℃で2時間はど焼成して前記誘電体層の表面に約7000人の厚さのMcの限(5i含有濃度が100000重量ppm)からなる保護限を形成して試料11を得た。

【0047】そして、上記試料 1~11の保護膜が形成された各前面用電極基板を用いたPDPを試作し、これら試作した各PDPの画質に対して図5に示す6段階の評価レベルにより評価を行って、試作PDPの各試料の保護膜(M $_{\rm E}$ O関)中のSi含有濃度と画質との関係を調べた。

【0048】 前記試作PDPの画質の評価は、該試作PDPを数十ライン置きに点灯ライン群と非点灯ライン群とが交互に並ぶ横ストライブパターンを表示させて目視検査によって行った。点灯ライン群の輝度レベルを最大輝度の約半分の「32」とした。即ち、重みが「32」のサブフレーム。10のを点灯させるサブフレーム 数が1であれば、1回のアドレスミスがフレーム 全体の消灯として現れる。また、煙度レベルが「32」であれば、正しく点灯したときとそうでないときとの弾度差が大きい。

【〇〇49】上述のように先頭ラインから頃に各ラインを選択してアドレッシングを行う場合には、各点灯ライン群における先頭ラインに最も近いラインで黒ノイズが発生しまい。ただし、常にアドレスミスが生じるとは限らないので、黒ノイズは発光のちらつきとして知覚される。ここでの黒ノイズの発光のちらつきとして知覚される。ここでの黒ノイズの発光のは、ブライミングの効果の少ない非常に点灯し難い条件での測定であるので、評価レベル3では実用的な使用に関しては全く問題のない良好なレベルであり、評価レベル2より画質が低いと文字が読みつらくなるが、評価レベル3以上の画質であれば実用的に問題はない。

【0050】前記試作PDPの各試料の保護膜(MeO膜)中のSi含有濃度と画質との関係を調べた結果を図6及び図7に示している。これら図6及び図7によって明らかなように、画質の良品範囲に対応する保護膜(MeO膜)中のSi含有濃度の許容範囲は、1000~4000重量ppmのSi含有濃度範囲の保護膜(MeO膜)において最良の画質が得られることが判明した。

【0051】なお、試作した各PDPの保護膜(Mgの 関)の組成(Mg, Mgの,Si等)を二次イオン質量分 析法(SIMS)で調べたところ、液状のMgとSiの 脂肪酸塩とを混合した塗布溶液により形成された塗布膜 の無分解によって得られたSiを含むMeO膜は、MeOm一部のMeを原子価が3以上の例えばSiで置換された様成となることから英空蒸音法により得られたSiを含むMeO膜に比べて、深さ方向(厚さ方向)へのSiの濃度分布が非常に均ってあり、その電気的特性も改善されるので、黒ノイズの時間的な変化が極めて少なく安定することが判った。

【0052】更に、以上の実施例では面放電型のカラー表示PDPを対象とした場合について説明しているが、本発明はそのようなPDPに限定されるものではなく、例えば対向放電型のPDP等にも適用することができることはいうまでもない。

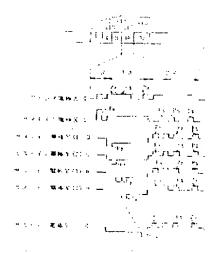
[0053]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明のプラズマディスプレイパネルによれば、脂肪酸塩の熱分解により形成したMeの映を保護膜として採用したプラズマディスプレイパネルにおいて、点灯すべきセルがらばしない "黒ノイズ"の発生率を著しく低減することができるので、表示品質を高めることが可能となり、実用上優れた効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明のPDPを用いたブラズマ表示装置の ブロック図である。
- 【図2】 フレーム 分割の模式図であ る。
- 【図3】 駆動シーケンスを示す電圧波形図である。
- 【図4】 本発明のPDPの内部構造を示す要部斜視図である。
- 【図 5 】 一試作PDPの画質の評価レベルを示す図である。
- 【図 6】 MgO膜のSi含有濃度と画質との関係を示す図である。
- 【図7】 試作のPDPの各試料のMェの膜中のS:含有濃度と画質の評価との関係を示す図である。
- 【符号の説明】
 - PDP
- 1 1, 2 1 ガラス荃板
- × サステイン電極
- Y サステイン電極
- A アドレス電極
- 17 誘電休層
- 18 McO膜(保護膜)
- 30 放電空間
- 80 駆動ユニット
- TA アドレス期間
- TR リセット期間 (初期化期間)
- TS サステイン期間

÷

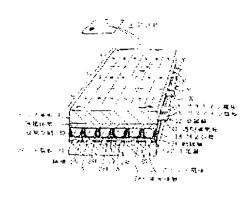


(B2)

15-16年於四個大阪



【図4】 「食物のドロドのお色料本を示す数率が増加



 (図6) がかり聞いた。おも親手を表すったを立ち、もう

 【図 7】 がなりいって高が行われてよって、シスト大兵事を は大学・たました場合できる。

	* 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -	2、展2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		_;=:-::
÷		
_!		

フロントページの続き

Fターム(参考) 40075 AE03 DA06 DB13 DC21 EC02 4J038 AA011 HA181 P803 5C027 AA06 5C040 GE07 JA21 KA03 KA05 KE03 KB19 KB28 MA17

. .